

# SJ

## 中华人民共和国电子工业部部标准

SJ 2214.1 ~ 2214.10—82

---

### 半导体光敏管测试方法

1982-11-30发布

1983-07-01实施

---

中华人民共和国电子工业部 批准

# 目 录

SJ 2214.1—82	半导体光敏管测试方法总则·····	( 1 )
SJ 2214.2—82	半导体光敏二极管正向压降的测试方法·····	( 2 )
SJ 2214.3—82	半导体光敏二极管暗电流的测试方法·····	( 3 )
SJ 2214.4—82	半导体光敏二极管反向击穿电压的测试方法·····	( 4 )
SJ 2214.5—82	半导体光敏二极管结电容的测试方法·····	( 5 )
SJ 2214.6—82	半导体光敏三极管集电极—发射极反向击穿电压的测试方法·····	( 6 )
SJ 2214.7—82	半导体光敏三极管饱和压降的测试方法·····	( 7 )
SJ 2214.8—82	半导体光敏三极管暗电流的测试方法·····	( 8 )
SJ 2214.9—82	半导体光敏二、三极管脉冲上升、下降时间的测试方法·····	( 9 )
SJ 2214.10—82	半导体光敏二、三极管光电流的测试方法·····	( 10 )